# ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

кадмия увеличивается эффективность взаимодействия ПАВ с электронами. При дальнейшем увеличении концентрации электронов проводимости амплитуда второй гармоники уменышается как вследствие сильного затухания волны основной частоты, так и вследствие экранирования пьезоэлектрических полей кристалла возникшим объемным зарядом. Первый фактор играет бо́льшую роль, поскольку амплитуда основной волны и волны второй гармоники ПАВ уменьшаются практически до нуля. Однако упругая нелинейность тоже приводит к генерации волны второй гармоники, что проявляется при еще больших проводимостях кристалла. В этом случае большую роль играет объемный заряд, который практически полностью экранирует пьезоэлектрическое поле кристалла, и пьезополупроводник можно рассматривать как полупроводник без пьезоэффекта. На рис. 1 приведены также зависимости напряжения продольного и поперечного акустоэлектрического эффекта в зависимости от проводимости.

Известно, что при малых проводимостях электронное затухание мало и пропорционально проводимости, поэтому акустоэлектрический ток также пропорционаленпроводимости, т. е. существует линейная область возрастания акустоэлектрического напряжения от проводимости. Создавая с помощью неравномерной подсветки локальные неоднородности проводимости, можно с помощью короткого импульса ПАВ наблюдать, как эти неоднородности проводимости проявлялись в сигнале акустоэлектри-. ческого напряжения. Этот эффект может использоваться для сканирования одномерных оптических образов [7].

При подаче двух радиоимпульсов одинаковой частоты на преобразователи, расположенные с разных сторон кристалла полупроводника, наблюдалось встречное взаимодействие ПАВ. Импульс удвоенной частоты снимался с электродов, нанесенных на боковые поверхности полупроводникового кристалла, представлял собой акустическую свертку двух сигналов. На рис. 2 изображена зависимость сигнала свертки для различного типа съема - продольного и поперечного - от проводимости сернистого кадмня. Максимумы сигнала свертки для различного типа съема находятся при различных проводимостях.

Совпадение полученных результатов с имеющимися теоретическими и экспериментальными данными из литературных источников показывает, что данная методика исследования акустоэлектронных эффектов в полупроводниках является удобной для оценки их эффективности и исследования анизотропии. Она также может найти применение для определения ряда характеристик пьезополупроводниковых и полупроводниковых монокристаллов с помощью ПАВ.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Kino G. S., Ludvik S. et al. «IEEE Trans. Sonics and Ultrasonics», 1973, SU-20, 162.
- 2. Кайно Г., Шоу Дж. «Успехи физических наук», 1974, 113, 157.
- 3. Коршак Б. А., Лямов В. Е., Солодов И. Ю. «Письма в ЖЭТФ», 1976, 23, 438.
- 4. Гончаров К. В., Крышнева Г. В., Маматова Т. А., Сулейманов С. Х. «Акустический журнал», 1975, 21, 527.
- 5. Кмита А. М., Медведь А. В., Мушкаренко Ю. Н., Федорец В. Н. «Акустический журнал», 1976, 22, 299.
- 6. Гуляев Ю. В., Кмята А. М., Медведь А. В., Федорец В. Н. «Письма в ЖЭТФ», 1974, 20, 700. 7. Takada S., Hayakawa H., Mikoshiba N. «Appl. Phys. Lett.», 1973, 23, 415.

Поступила в редакцию 20.6 1976 г. Кафедра акустики

УДК 534—12

М. И. Аржанов Ф. В. Рожин О. С. Тонаканов

РАДИАЛЬНАЯ И АЗИМУТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БЛИЖНЕГО ЗВУКОВОГО ПОЛЯ ПРИ РАССЕЯНИИ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ НА КРУГЛОМ ЦИЛИНДРЕ

В работе [1] рассматривалась задача о ближнем поле звукового давления и колебательной скорости при рассеивании плоской звуковой волны на бесконечном круговом цилиндре радиуса ro с акустически мягкой и жесткой границами. В этой работе приведено аналитическое решение для компонентов скорости и проведен расчет структуры поля для точки, удаленной на расстояние  $r=1,2r_0$  от оси цилиндра. Полученные в [1] диаграммы характеризуют зависимость амплитуды суммарного поля падающей и рассеянной волны в функции угла падения волны  $\theta$  (при  $\phi=0$ ) и в функции ази-мутального угла  $\phi$  (при  $\theta=0$ ). Вследствие недостаточного применения вычислительной техники полная структура поля не была выявлена; в частности, не была рассчитана структура поля при различных удалениях *г* от оси цилиндра. Использование ЭВМ позволило завершить теоретическое исследование амлитудной структуры ближнего поля.

Решение задачи дифракции плоской звуковой волны на бесконечном круглом цилиндре для каждой из величин давления и компонентов колебательной скорости дается суммой бесконечного комплексного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} Z_n = \sum_{n=0}^{\infty} X_n + j \sum_{n=0}^{\infty} Y_n$$

Для практических расчетов важно установить критерий, при выполнении которого можно закончить вычисление членов ряда. Самым надежным критерием является

нахождение остатков рядов  $\sum_{n=N}^{\infty} X_n$  и  $\sum_{n=M}^{\infty} Y_n$  и сравнение их с малой величиной  $\varepsilon$ .

Очевидно, вычисление ряда должно быть прекращено при значении  $n = \max\{N, M\}$ , обеспечивающем выполнение условий

$$\Big|\sum_{n=N}^{\infty} X_n\Big| < \varepsilon, \Big|\sum_{n=M}^{\infty} Y_n\Big| < \varepsilon.$$

Сходимость рядов  $\sum_{n=0}^{\infty} X_n$  и  $\sum_{n=0}^{\infty} Y_n$  одинакова, поэтому достаточно оценить остатокодного из них. Как показывает анализ, решение для компонента скорости  $V_{\infty}$  сходит-

ся хуже остальных (*P*,  $V_z$ ,  $V_{\theta}$ ), поэтому проведем оценку ряда  $R_N$ , определяющего действительную часть  $V_{\phi}$  в случае нормального падення ( $\theta$ =0):

$$R_N = \sum_{\lfloor n=N}^{\infty} n \sin(n \varphi) \sin\left(n \frac{\pi}{2} - \gamma_n\right) \left[I_n(kr) \cos \gamma_n - N_n(Kr) \sin \gamma_n\right],$$

где  $\gamma_n = \arctan \frac{\ln (Kr_0)}{N_n (Kr_0)}$  для акустически мягкого цилиндра.

Рассмотрение поведения отдельных членов ряда  $R_N$  при фиксированном Kr и возрастании номера *n* приводит при  $N > Kr/2 (e^2 + 1/e^2)$  к оценке остатка

$$\frac{-\frac{N+1}{2}}{R_N < e} = \frac{e}{1-e^{-1}}$$

При вычислении остатка для  $I_n(Kr)$  использовалось разложение, приведенное в [2], которое дает в первом приближении:

$$I_n(Kr) = \frac{1}{\sqrt{2\pi (n^2 - (Kr^2))_1}} e^{-n \left[ \ln \frac{\left[ n \sqrt{n^2 - (Kr)^2}}{\sqrt{Kr}} - \sqrt{1 - \frac{(Kr)^2}{\sqrt{n}}} \right] \right]}$$

Следовательно, при вычислении членов комплексных рядов до номера  $N_{\min}$  [N] обеспечивается погрешность величины компонента  $V_{\phi}$ , не превышающая  $\epsilon \sqrt{2}$ . Очевидно, при ограничении числа членов ряда  $N_{\min}$  остальные компоненты поля будут вычисляться с погрешностью, не превышающей в  $\sqrt{2}$ . Отметим, что в случае акустически жесткого цилиндра получается та же самая оценка.

Расчет на БЭСМ-4 ближнего поля проводился для значений нараметра  $Kr_0$ : 0,25  $\leq Kr_0 \leq 8$ . Распределение амплитуд давления и компонентов скорости в зависимости от удаления r ( $r_0 < r \leq r_0 + 8 \lambda$ ) от осн акустически мягкого цилиндра приведено на рис. 1 ( $Kr_0=1$ ) и на рис. 2 ( $Kr_0=8$ ) для трех значений азимутального угла  $\varphi$ (сплошная линия  $\varphi=5^\circ$ , штриховая —  $\varphi=85^\circ$  и штрихпунктирная —  $\varphi=165^\circ$ ) при нормальном падении волны ( $\theta=0$ ). Из расчетов следует, что зона, где рассеянная волна пренебрежимо мала по сравнению с падающей, за цилиндром лежит на расстоянии меньшем, чем  $r_0+8\lambda$ , даже при  $Kr_0=8$ , а перед цилиндром на расстоянии большем, чем  $r_0+8$ , даже при  $Kr_0=0,25$ .

Зависимости амплитуд давления и компонентов скорости от азимутального угла  $\varphi$  (при  $\theta=0$ ) в области  $r_0 < r < r_0 + \lambda/4$  аналогичны полученным в [1]. При большем уда-



104

### СЕРИЯ ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ, Т. 18, № 1, 1977

лении они приведены на рис. З для различных удалений точки наблюдения от оси цилиндра и  $Kr_0 = 1$  (сплошная линия при  $r = r_0 + 8\lambda$ , штриховая при  $r = r_0 + 2\lambda$  и штрихпунктирная при  $r = r_0 + \lambda$ ).

### ЛИТЕРАТУРА

Картавенко А. И., Киршов В. А., Тонаканов О. С. «Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон.», 1971, 12, № 4, 376—382.
Шендеров Е. Л. Волновые задачи гидроакустики. М., 1972.

Поступила в редакцию 6.9 1976 г. Кафедра акустики

УДК 621.317.733.77

В. П. Комолов В. А. Рознятовский

#### ОБ УДАРНОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ возбуждении в контуре С НЕЛИНЕЙНОЙ ЕМКОСТЬЮ

Параметрические системы (ПС) с медленно и быстро меняющимися параметрами хорошо исследованы и широко применяются в качестве ЧМ-фильтров, делителей и умножителей частоты. Практический интерес представляет также исследование ПС со скачкообразно меняющимися параметрами. В избирательной ПС при определенных начальных условиях скачкообразное изменение энергоемкого параметра приводит к ударному параметрическому возбуждению затухающих колебаний, несущих информацию о начальных условиях. Это обстоятельство может оказывать существенное влияние на чувствительность коммутируемых ПС-типа параметронов и параметрических квантователей фазы, применяющихся для регистрации слабых сигналов, и может быть использовано для создания быстродействующих параметрических квантователей фазы<sup>1</sup>.

На рис. 1, а показана схема LC-контура ПКФ. Емкость С, равная общей емкости че-тырех одинаковых варикапов типа МДП, соединенных по балансной мостовой схеме, может быть близка по своим своиствам к идекоторая не альной управляемой емкости, зависит от напряжения на контуре, но может управляться напряжением смещения на варикапах (напряжением накачки) U<sub>H</sub>(t), создаваемым отдельным генератором. Зависимость С от U<sub>н</sub> показана на рис. 1, б. Очевидно, что при видеоимпульсном напряжении  $U_{\mu}(t)$ , меняющемся от значения  $U_{\rm H} > U_{\rm Hmax}$  до значения:





 $U_{\rm H} < U_{\rm Hmin}$ , емкость C скачкообразно меняется от Стах до Стіп. На рис. 2, а показано изменение идеальной емкости C(t), управляемой видеоимпульсным напряжением накачки. На рис. 2, б, в, г показаны осциллограммы колебаний напряжения на емкости U(t), тока в контуре I(t), заряда конденсатора q(t) для аналоговой модели автономного контура без потерь, описываемого уравнением

<sup>1</sup> См. В. П. Комолов, И. Т. Трофименко. Квантование фазы при обнаружении радиосигналов. М., 1976.